Высокая стойкость к электротермоциклированию
Низкие статические и динамические потери
Разработан для промышленного применения

Низкочастотный Диод
Тип Д143-1250-18

Средний прямой ток			I_{FAV}	1250 А	
Повторяющееся импульсное обратное напряжение			U_{RRM}	1000 ÷ 1800 В	
U_{RRM}, В	1000	1200	1400	1600	1800
Класс по напряжению	10	12	14	16	18
T_j, °C	-60 ÷ 190				

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{FAV}	Средний прямой ток	А	1250 1500	T_c=121 °C; двухстороннее охлаждение; T_c=100 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{FRMS}	Действующий прямой ток	А	1963	T_c=121 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{FSM}	Ударный ток	кА	22.0 25.0	T_j=$T_{j\,max}$ T_j=25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t_p=10 мс); единичный импульс; U_R=0 В;
			24.0 28.0	T_j=$T_{j\,max}$ T_j=25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t_p=8.3 мс); единичный импульс; U_R=0 В;
I^2t	Защитный фактор	$А^2с\cdot10^3$	2420 3125	T_j=$T_{j\,max}$ T_j=25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t_p=10 мс); единичный импульс; U_R=0 В;
			2390 3250	T_j=$T_{j\,max}$ T_j=25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t_p=8.3 мс); единичный импульс; U_R=0 В;
Блокирующие параметры					
U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение	В	1000÷1800	$T_{j\,min}$< T_j <$T_{j\,max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	В	1100÷1900	$T_{j\,min}$< T_j <$T_{j\,max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс	
U_R	Постоянное обратное напряжение	В	0.75·U_{RRM}	T_j=$T_{j\,max}$;	
Тепловые параметры					
T_{stg}	Температура хранения	°C	-60÷190		
T_j	Температура p-n перехода	°C	-60÷190		
Механические параметры					
F	Монтажное усилие	кН	14.0÷16.0		
a	Ускорение	$м/с^2$	50 100	В не зажатом состоянии В зажатом состоянии	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Характеристики в проводящем состоянии					
U_{FM}	Импульсное прямое напряжение, макс	В	1.65	T_j=25 °C; I_{FM}=3925 А	
$U_{F(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	0.95	$T_j=T_{j\ max}$; $0.5\ \pi\ I_{FAV} < I_T < 1.5\ \pi\ I_{FAV}$	
r_T	Динамическое сопротивление, макс	мОм	0.250		
Блокирующие характеристики					
I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток, макс	мА	70	$T_j=T_{j\ max}$; $U_R=U_{RRM}$	
Динамические характеристики					
Q_{rr}	Заряд обратного восстановления, макс	мкКл	2000	$T_j=T_{j\ max}$; I_{TM}=1250 А; di_R/dt=-10 А/мкс; V_R=100 В	
t_{rr}	Время обратного восстановления, макс	мкс	25.0		
I_{rrM}	Ток обратного восстановления, макс	А	160		
Тепловые характеристики					
R_{thjc}	Тепловое сопротивление p-n переход-корпус, макс	°C/Вт	0.0320	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
R_{thjc-A}			0.0704		Охлаждение со стороны анода
R_{thjc-K}			0.0576		Охлаждение со стороны катода
R_{thck}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	°C/Вт	0.0060	Постоянный ток	
Механические характеристики					
w	Масса, тип	г	260		
D_s	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	23.69 (0.933)		
D_a	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	19.10 (0.752)		

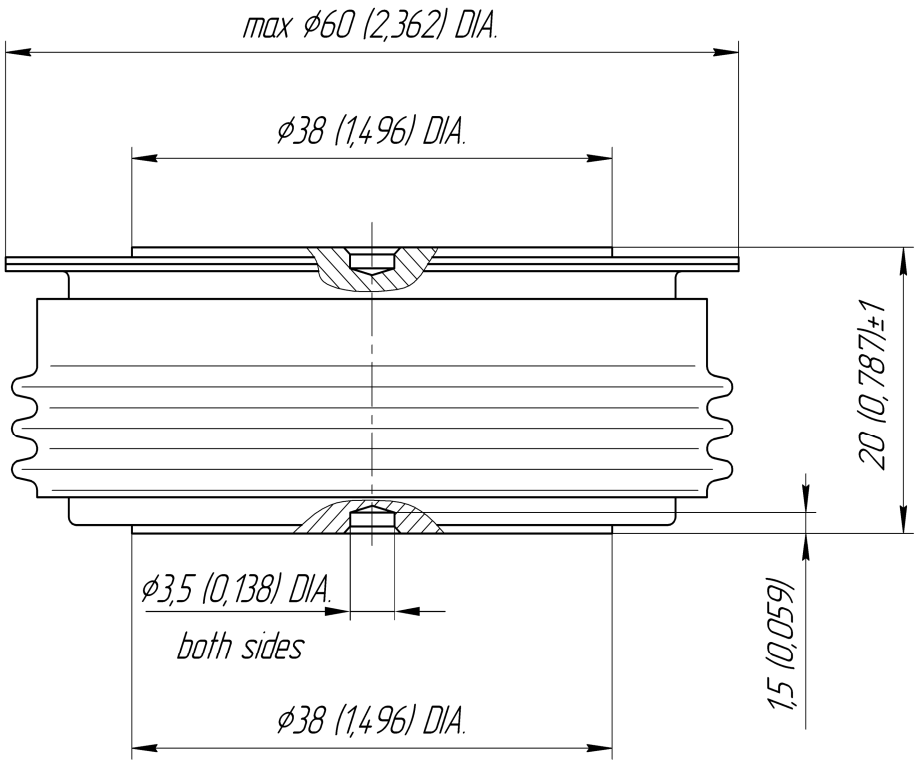
МАРКИРОВКА

Д	143	1250	18	УХЛ2
1	2	3	4	5

1. Д — Низкочастотный диод
2. Конструктивное исполнение
3. Средний прямой ток, А
4. Класс по напряжению
5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: D.C2



Все размеры в миллиметрах (дюймах)

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав.
В интересах улучшения качества продукции, ЗАО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без уведомления.

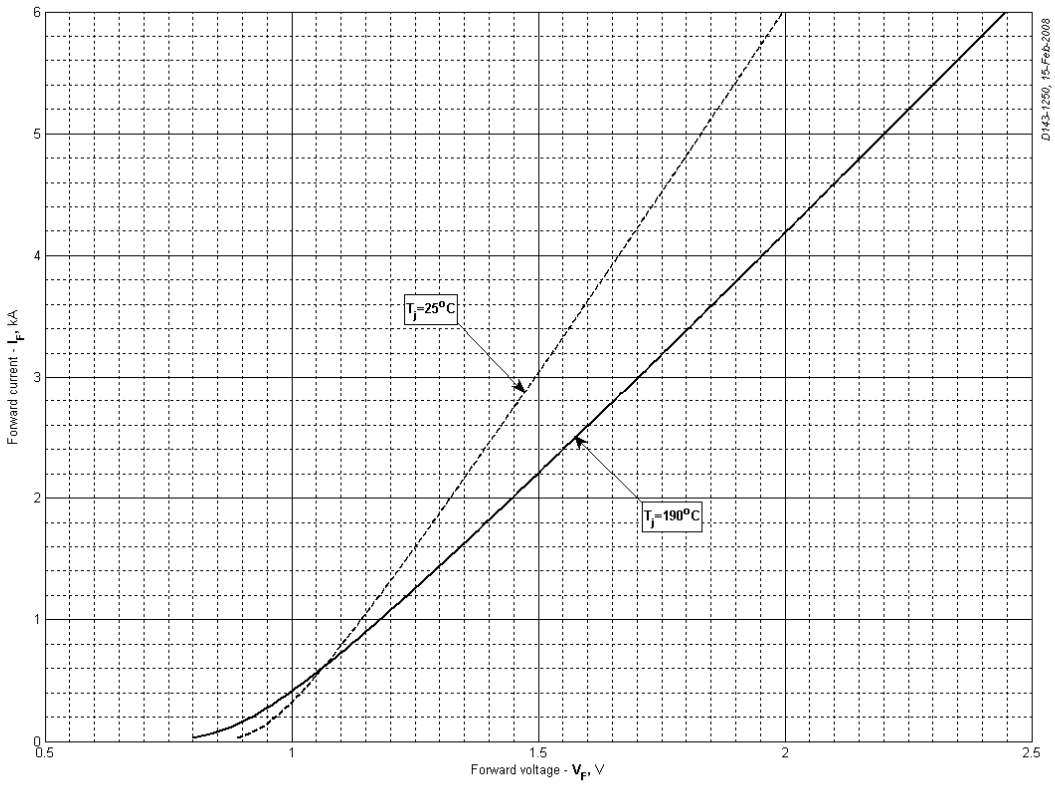


Fig 1 – On-state characteristics of Limit device

Analytical function for On-state characteristic:

$$V_F = A + B \cdot i_F + C \cdot \ln(i_F + 1) + D \cdot \sqrt{i_F}$$

	Coefficients for max curves	
	T_j = 25°C	$T_j = T_{j\,max}$
A	0.843100	0.728162
B	0.131160	0.191782
C	-0.172583	-0.268141
D	0.286381	0.444947

On-state characteristic model (see Fig. 1)

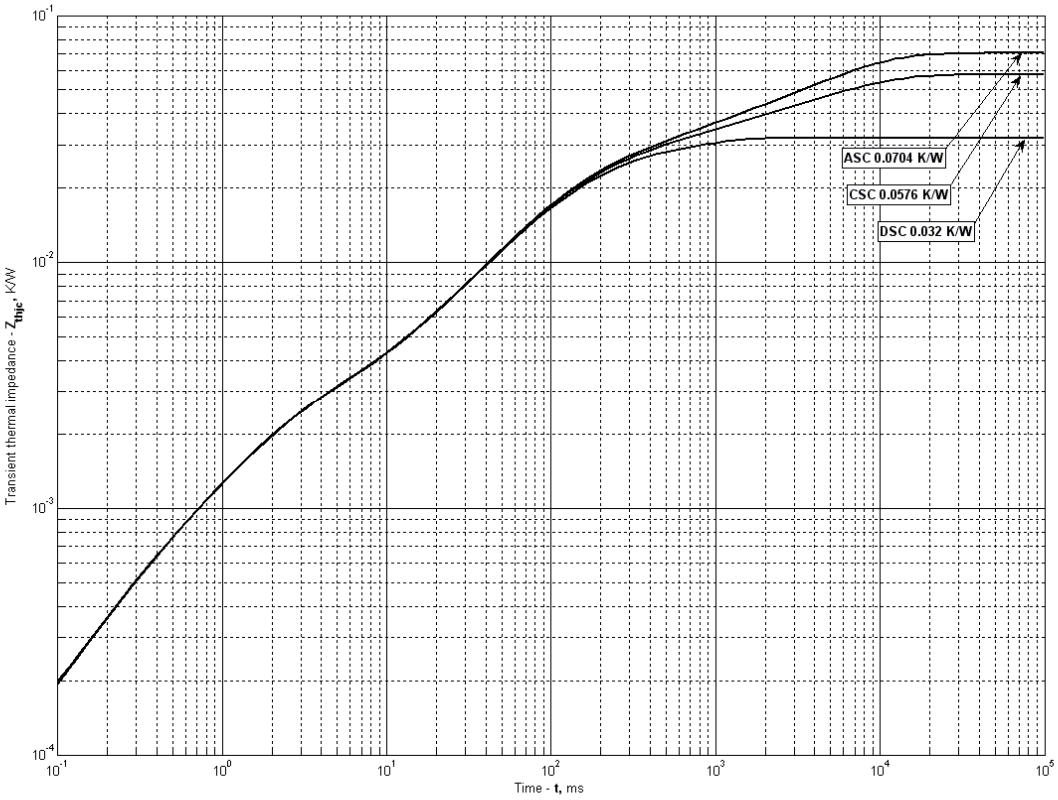


Fig 2 – Transient thermal impedance

Analytical function for Transient thermal impedance junction to case Z_{thjc} for DC:

$$Z_{thjc} = \sum_{i=1}^{n} R_i \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_i}} \right)$$

Where ***i*** = 1 to ***n***, ***n*** is the number of terms in the series.

t = Duration of heating pulse in seconds.

$\mathbf{Z_{thjc}}$ = Thermal resistance at time t.

$\mathbf{R_i}$ = Amplitude of p_{th} term.

$\boldsymbol{\tau_i}$ = Time constatnt of r_{th} term.

DC Double side cooled

i	1	2	3	4	5	6
$\mathbf{R_i}$, **K/W**	0.000005619	0.01031	0.01922	0.0004148	0.001895	0.0001521
$\boldsymbol{\tau_i}$, **s**	7.790	0.5094	0.09719	0.01725	0.0016	0.0002257

DC Anode side cooled

i	1	2	3	4	5	6
$\mathbf{R_i}$, **K/W**	0.0381	0.008681	0.01867	0.001961	0.0001787	0.002771
$\boldsymbol{\tau_i}$, **s**	5.351	0.4584	0.09325	0.001734	0.0002174	0.9059

DC Cathode side cooled

i	1	2	3	4	5	6
$\mathbf{R_i}$, **K/W**	0.02561	0.001472	0.01786	0.001926	0.0001928	0.01052
$\boldsymbol{\tau_i}$, **s**	5.328	0.1832	0.09031	0.001714	0.0002598	0.525

Transient thermal impedance junction to case $\mathbf{Z_{thjc}}$ model (see Fig. 2)

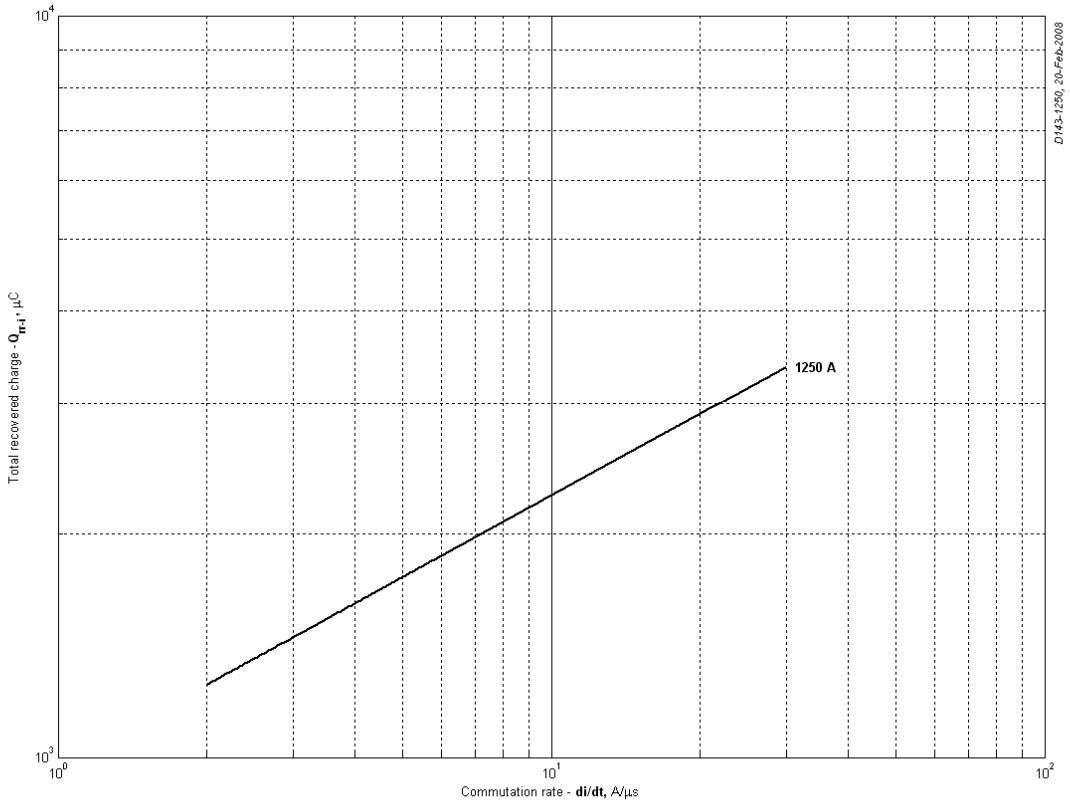


Fig 3 – Total recovered charge, Q_{rr-i} (integral)

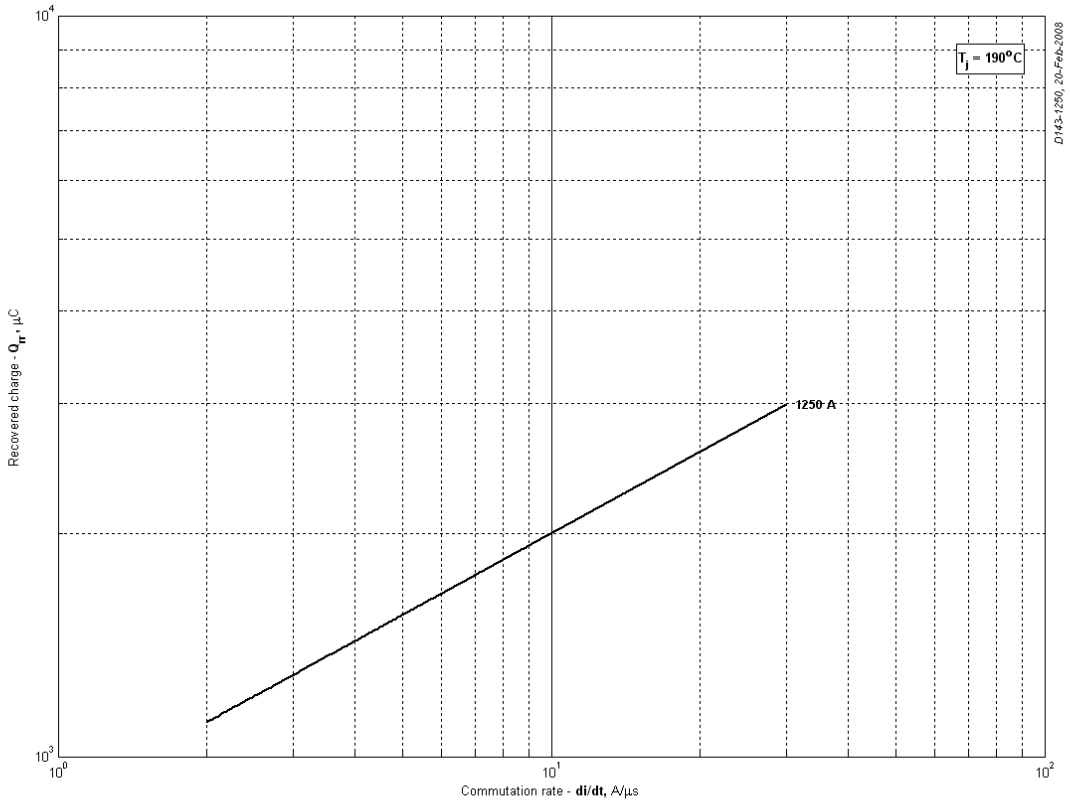


Fig 4 - Recovered charge, Q_{rr} (linear)

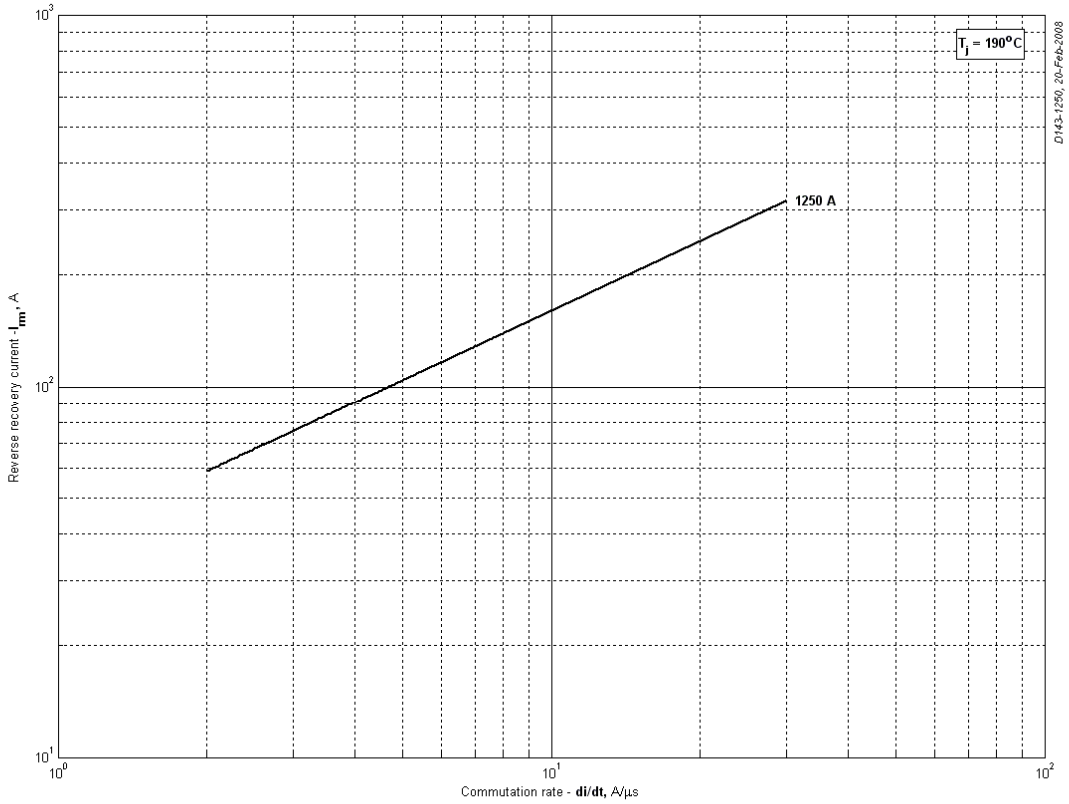


Fig 5 – Peak reverse recovery current, I_{rm}

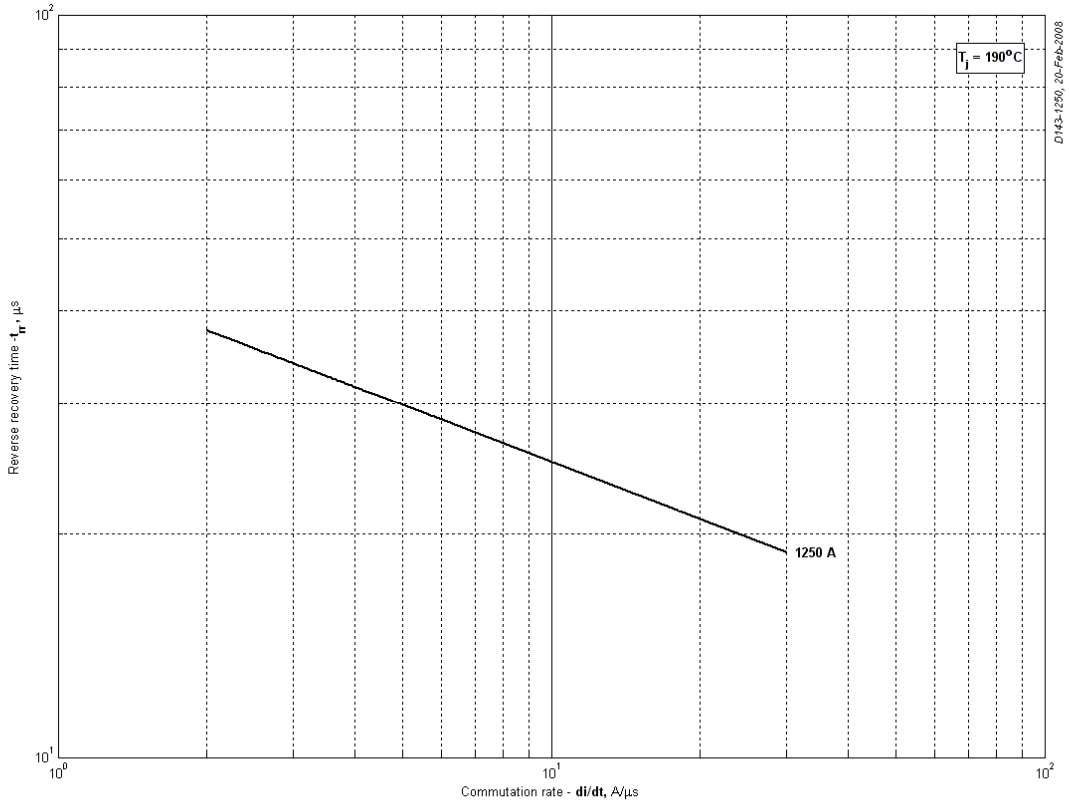


Fig 6 – Maximum recovery time, t_{rr} (linear)

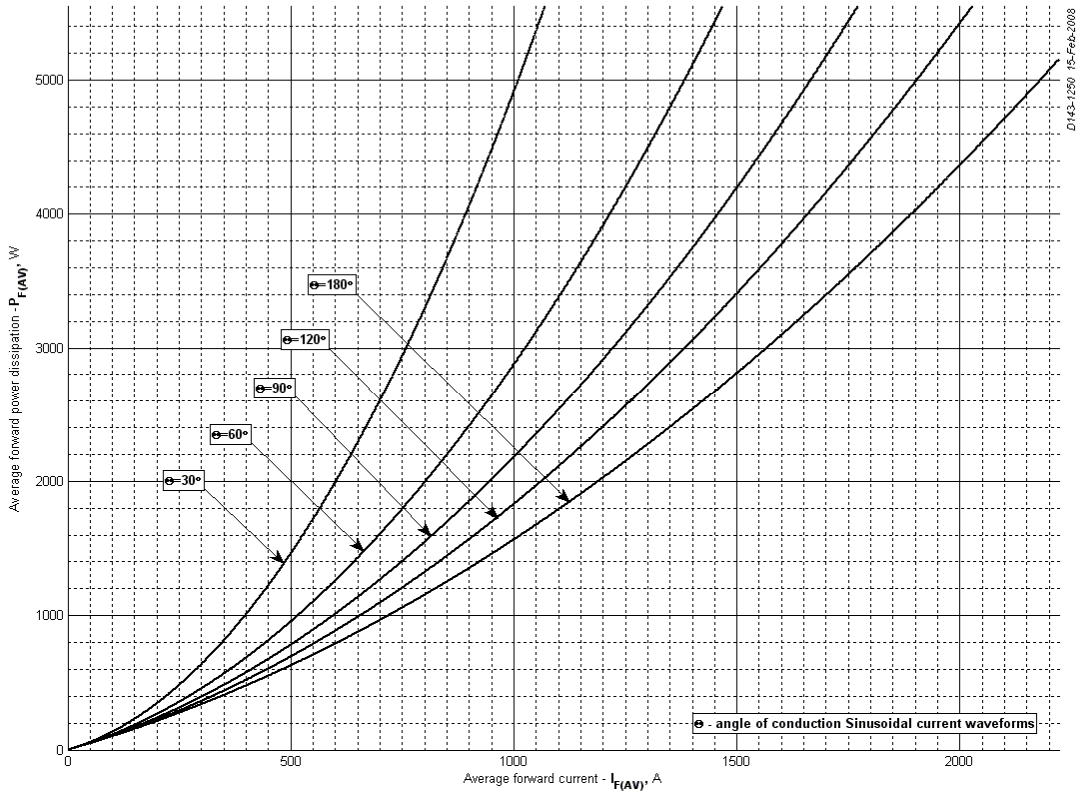


Fig 7 – On-state power loss (sinusoidal current waveforms)

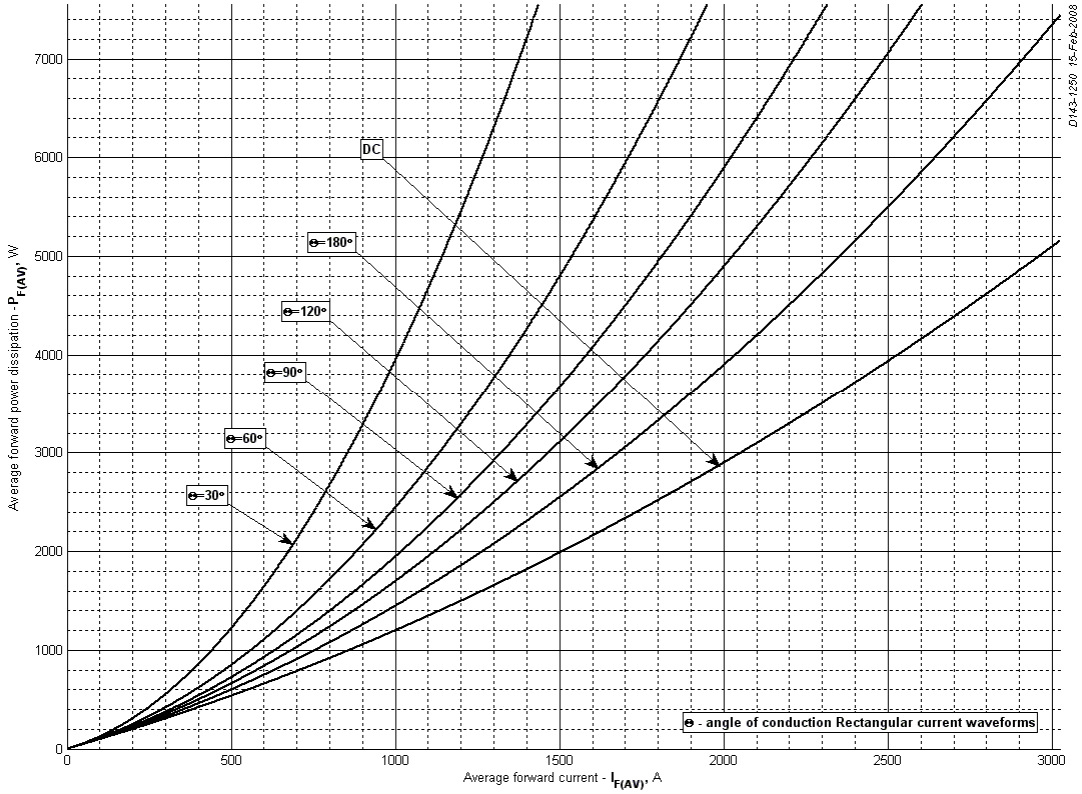


Fig 8 – On-state power loss (rectangular current waveforms)

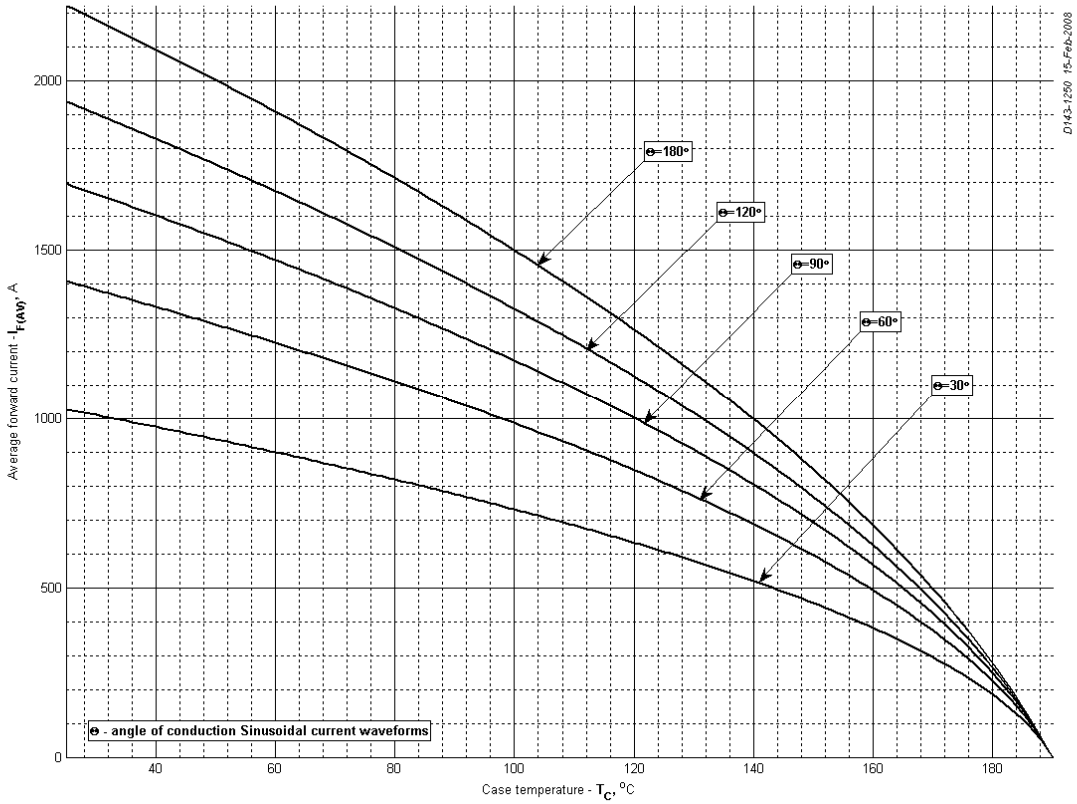


Fig 9 – Maximum case temperature DSC (sinusoidal current waveforms)

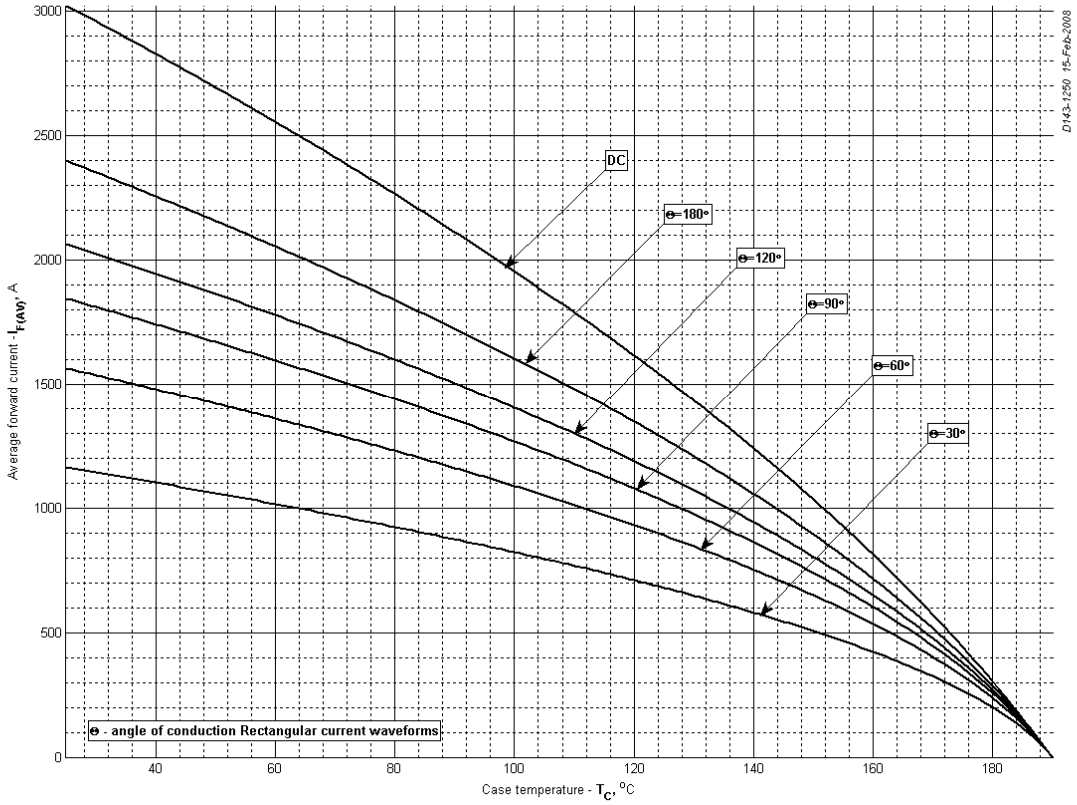


Fig 10 – Maximum case temperature DSC (rectangular current waveforms)

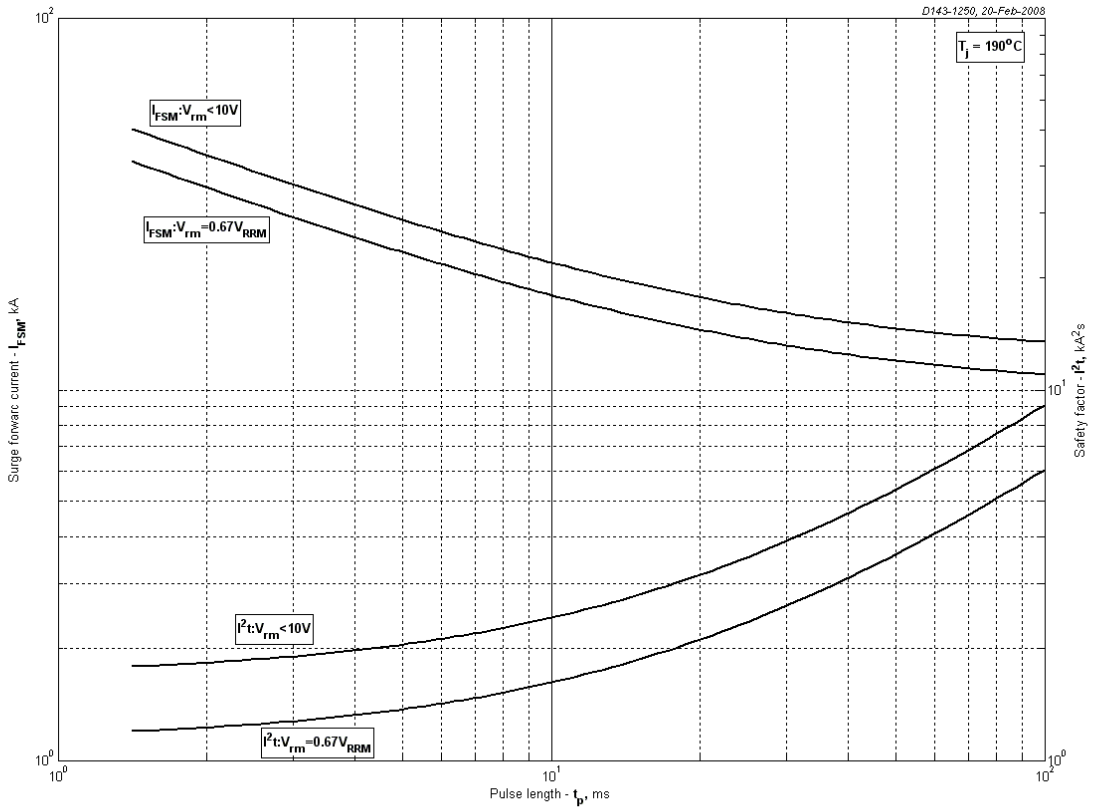


Fig 11 – Maximum surge and I^2t ratings

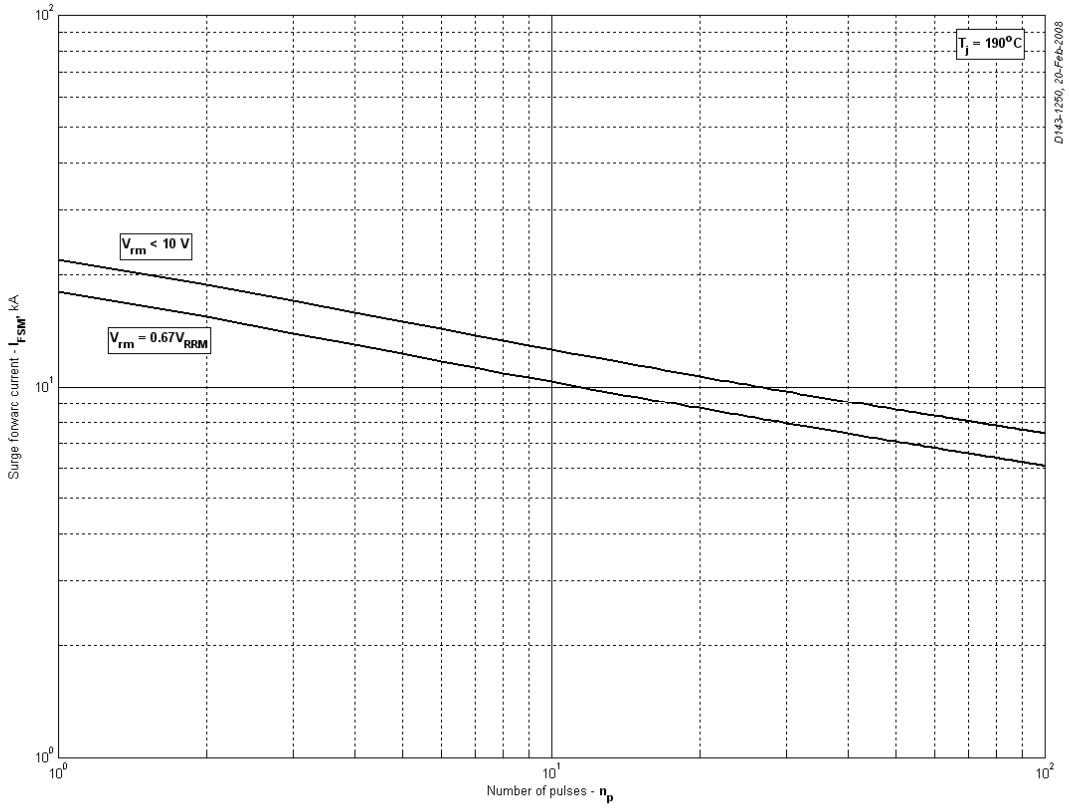


Fig 12 – Maximum surge ratings